

東芝ダイオード シリコンエピタキシャルプレーナー形

1SS387

○ 超高速スイッチング用

- AEC-Q101 適合 (注 1)
- 2 端子小型外囲器なので、高密度実装に最適です。
- 順方向特性が良い。 : $V_F(3) = 0.98 \text{ V}$ (標準)
- 逆回復時間が短い。 : $t_{RR} = 1.6 \text{ ns}$ (標準)
- 端子間容量が小さい。 : $C_T = 0.5 \text{ pF}$ (標準)

注 1: 詳細については弊社営業窓口へお問合せ下さい。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
せん頭逆電圧	V_{RM}	85	V
逆電圧	V_R	80	V
せん頭順電流	I_{FM}	200	mA
平均整流電流	I_O	100	mA
サージ電流 (10ms)	I_{FSM}	1	A
許容損失	P_D (注 2, 4)	200	mW
	P_D (注 3, 4)	150	
接合温度	T_j (注 2)	150	$^\circ\text{C}$
	T_j (注 3)	125	
保存温度	T_{stg} (注 2)	-55~150	$^\circ\text{C}$
	T_{stg} (注 3)	-55~125	

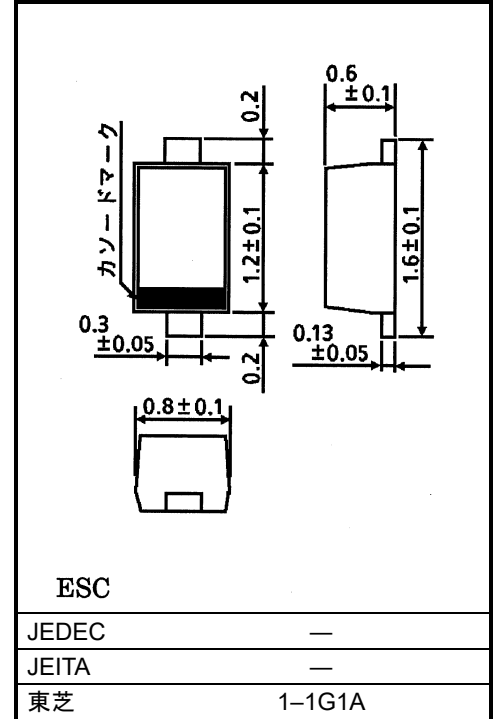
注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
 弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 2: オーダー品番の末尾が L3F(T の製品に適用されます。

注 3: オーダー品番の末尾が L3F(T 以外の製品に適用されます。

注 4: 基板実装時 (ガラスエポキシ基板面積: 20 mm x 20 mm, 銅箔パッド面積: 4 mm x 4 mm)

単位: mm



質量: 1.4mg (標準)

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
順電圧	V _F (1)	I _F = 1 mA	—	0.62	—	V
	V _F (2)	I _F = 10 mA	—	0.75	—	
	V _F (3)	I _F = 100 mA	—	0.98	1.20	
逆電流	I _R (1)	V _R = 30 V	—	—	0.1	μA
	I _R (2)	V _R = 80 V	—	—	0.5	
端子間容量	C _T	V _R = 0 V, f = 1 MHz	—	0.5	3.0	pF
逆回復時間	t _{rr}	I _F = 10 mA (図 1)	—	1.6	4.0	ns

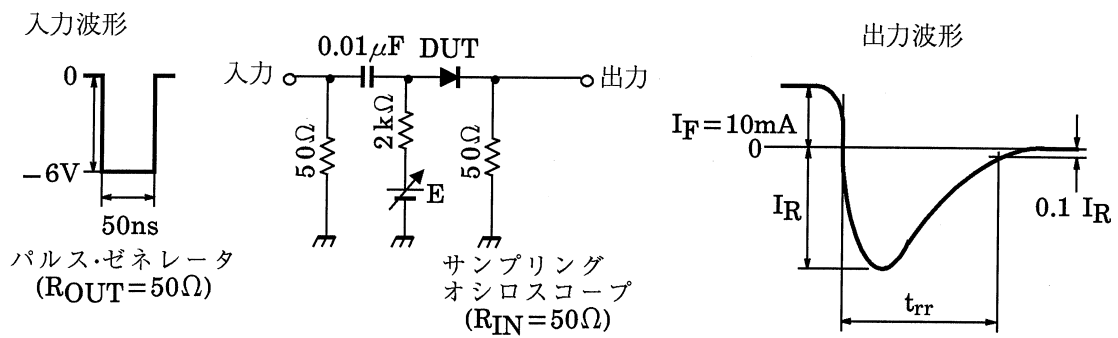
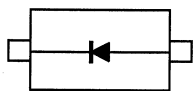
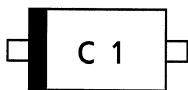


図 1. 逆回復時間 (t_{rr}) 測定回路

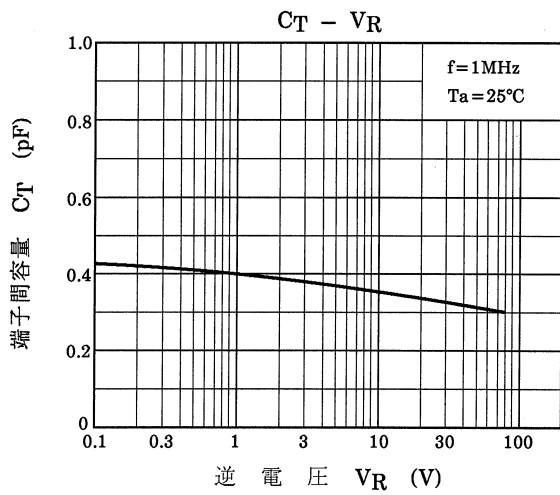
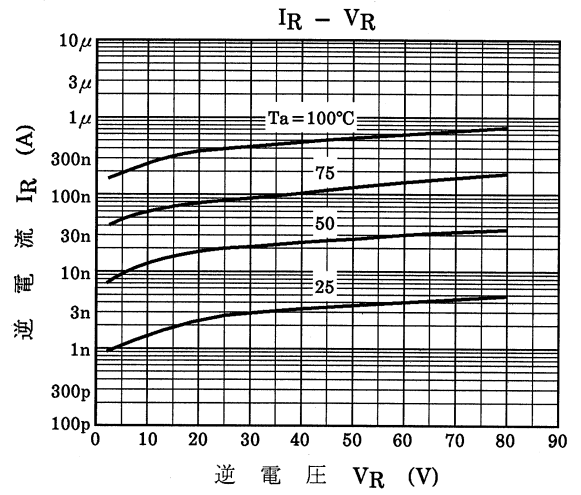
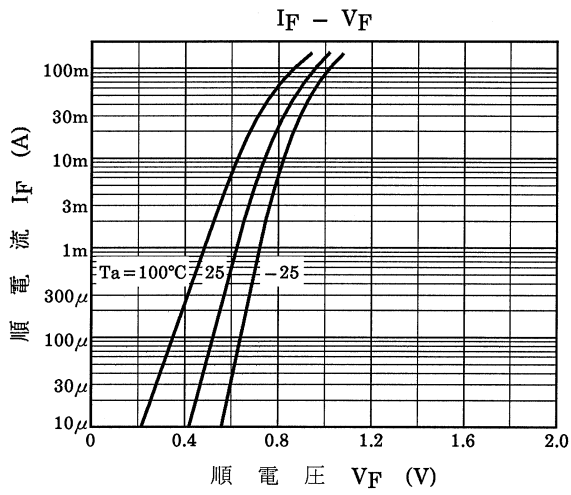
内部接続 (Top View)



現品表示



特性図



特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。